证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-030

有研半导体硅材料股份公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月1日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月1日 13点30分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日

至2025年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定和修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	对外担保管理制度	√
2.05	对外担保管理制度	√
2.06	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	√
2.07	独立董事工作制度	√
2.08	累积投票制实施细则	√
2.09	股东会网络投票实施细则	√
2.10	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
2.11	征集投票权实施细则	√
2.12	融资决策制度	√
2.13	对外投资管理制度	√
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	√
4	关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2025/8/25

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2025年8月29日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱gritekipo@gritek.com进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编：100088

联系人：孙媛

电 话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年8月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于制定和修订部分公司治理制度的议案			
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
2.03	关联交易管理制度			
2.04	对外担保管理制度			
2.05	对外担保管理制度			
2.06	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度			
2.07	独立董事工作制度			
2.08	累积投票制实施细则			
2.09	股东会网络投票实施细则			
2.10	董事和高级管理人员薪酬管理制度			
2.11	征集投票权实施细则			
2.12	融资决策制度			
2.13	对外投资管理制度			
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案			
4	关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-027

有研半导体硅材料股份公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到孙根志华先生提交的书面辞职报告。因个人原因，孙根志华先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务，孙根志华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名黄莺女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙根志华	独立董事、董事会提名委员会委员	自公司股东会选举产生新的独立董事之日	2027年5月26日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，孙根志华先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，且孙根志华先生未担任董事会下属各委员会的召集人，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。但其辞职会导致公司董事会提名委员会的独立董事未过半数，因此孙根志华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙根志华先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告披露之日，孙根志华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙根志华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事候选人的情况

公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，根据控股股东株式会社RS Technologies推荐，经提名委员会审核，董事会同意提名黄莺女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

黄莺女士已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训并取得相应培训记录证明。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东会审议。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，若黄莺女士当选公司独立董事，将同时担任董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年8月14日

附：独立董事候选人简历

黄莺女士，1963年出生，中国国籍，具有日本境外永久居留权，博士研究生学历。2004年6月至2018年1月任职安永新日本有限责任会计师事务所担任中国业务负责人；2018年2月至2025年6月任职普华永道日本合同会社担任中国业务负责人；2024年4月至今任职日本中央大学担任讲师；2025年7月至今任职Osmanthus United LLC担任首席执行官。

截至本公告披露日，黄莺女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-028

有研半导体硅材料股份公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金100,056.36万元，本年度实际使用募集资金8,140.86万元。截至2025年06月30日，募集资金余额为63,576.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为13,576.75万元，与募集资金余额相差50,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	158,569,195.04
减：本年度投入募集资金总额	81,408,618.50
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	-2,917,350.81
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-50,000,000.00
减：支付的其他发行费用	-
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	5,689,609.20
募集资金专项账户期末余额	135,767,536.55

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司（及子公司）、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年06月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行名称	银行账号	金额
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	3,757.58
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.22
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	3,227.52
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.36
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	6,314.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）

截至2025年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	27,000.00	2025.06.20-2025.09.18	否
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	18,000.00	2025.04.01-2025.07.02	否
浦发银行北京分行	结构性存款	浮动收益	5,000.00	2025.06.26-2025.09.25	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年8月14日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(注1)				1,663,967,265.37		本年度投入募集资金总额					81,408,618.50	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,081,972,238.13	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、年产2英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
2、年产8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
3、年产12英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
4、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
5、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
6、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
7、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
8、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
9、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
10、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
11、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
12、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
13、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
14、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
15、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
16、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
17、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
18、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
19、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
20、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
21、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
22、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
23、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
24、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
25、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
26、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
27、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
28、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
29、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
30、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
31、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
32、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
33、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
34、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
35、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
36、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
37、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
38、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
39、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
40、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
41、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
42、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
43、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
44、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
45、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
46、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
47、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
48、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
49、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
50、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
51、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
52、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
53、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
54、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
55、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
56、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
57、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
58、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
59、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
60、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
61、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
62、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
63、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%	2025年12月	-1,232.04	否	否
64、区熔硅单晶技术研发及产业化项目	否	185,458.87	185,458.87	185,458.87	8,140.86	100,056.36	-85,402.51	53.96%